Bauelement	Bipolar-Transistor	n-Kanal-MOSFET
Aufbau (schematisch)	B1 E B2	S G D  n
Stromfluß	vertikal	lateral
kritische Abmessung für Grenzfrequenz	Basisweite	Kanallänge
Rauschen (Hauptursachen)	Schrotrauschen, Widerstandsrauschen	Widerstandsrauschen 1/f-Rauschen
Strom-Spannungs- charakteristik	exponentiell	quadratisch (im Sättigungsgebiet)
Übertragungsleitwert, Steilheit	$g_{\rm m} = \frac{I_{\rm C}}{V_{\rm T}}$	$g_{\rm m} = \sqrt{2\beta_{\rm n}I_{\rm D}}$
Steuerstrom	$I_{\rm B} = I_{\rm C}/B_{\rm N}$	I <sub>G</sub> = 0
Kontrolle der Schaltschwelle	besser	schlechter